



Amcom

COMMUNICATIONS

The RF Power House



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
МОНОЛИТНЫЕ СВЧ ИС (ММИС)
СВЧ УСИЛИТЕЛИ В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
ДИСКРЕТНЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ
УПРАВЛЯЕМЫЕ АТТЕНУАТОРЫ И ФАЗОВРАЩАТЕЛИ**

www.amcomusa.com

Информация о компании



ISO 9001:2008 Certified

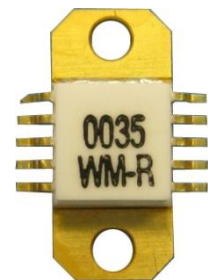
Компания AMCOM Communications была основана в декабре 1996 года группой СВЧ разработчиков, обладающих значительным опытом как в разработке СВЧ топологии, так и в технологии производства.

AMCOM Communications заслуженно завоевала репутацию инновационного разработчика и производителя дискретных полевых транзисторов, СВЧ микросхем - усилителей мощности (ММІС), мощных усилительных модулей в исполнении, готовом для интеграции в аппаратуру заказчика.

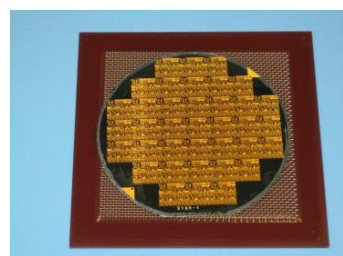
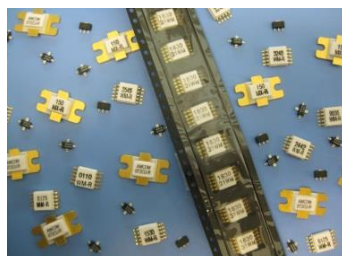
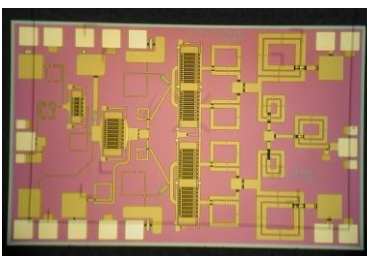
Линейка производимых СВЧ интегральных схем обеспечивает выходную мощность от 10 мВт до 16 Вт в диапазоне частот 10 МГц - 14,5 ГГц. Компания также известна своими широкополосными высокоэффективными усилителями мощности в модульном исполнении: сотни Ватт в диапазоне от 20 МГц до 1000 МГц; десятки Ватт в диапазоне от 20 МГц до 3000 МГц.

Продукция компании широко используется в различных лабораторных системах, радарх, системах связи.

AMCOM Communications самостоятельно разрабатывает топологию, а затем передает заказ на полупроводниковую фабрику для производства пластин, либо использует готовые кристаллы, в том числе по технологиям LDMOS и GaN. После получения кристаллов, AMCOM обладает мощностями для корпусирования, сборки модулей, а также тестирования по СВЧ параметрам (которое производится до отправки продукции заказчику).



Информация о продукции Amcom Communications, не представленной в данном каталоге, доступна у официального представителя компании в Вашем регионе, а также на интернет-сайте производителя.



СВЧ транзисторы

(ECCN код: EAR99)

GaAs pHEMT (высокая плотность мощности и хороший КПД)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1дВ} (дБм)	IP3 (дБм)	Vd (В)
AM005WX-BI-R	0-12	17	24.5	25.5	8
AM010WX-BI-R	0-12	16	28.5	30	8
AM030WX-BI-R	0-10	14	33	34	8
AM060WX-BI-R	0-10	13.5	35.5	36.5	8
AM090WX-CU-R	0-6	12	37	45	8
AM120WX-CU-R	0-6	11.5	38	46	8
AM005WH2-BI-R	0-12	20	26	27	14
AM010WH2-BI-R	0-12	18	30	31	14
AM020WH2-BI-R	0-12	18	33	34	14
AM030WH2-BI-R	0-12	18	34.5	36	14
AM060WH2-CU-R	0-12	17	38	38.5	14
AM120WH2-CU-R	0-12	16	39	39.5	14
AM030WH4-BI-R	0-6	21	37	37	28

GaAs FET (высокая линейность)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1дВ} (дБм)	IP3 (дБм)	Vd (В)
AM006MX-QG-R	0-6	13	22	34	5
AM012MX-QG-R	0-6	13.5	25	37	5
AM024MX-QG-R	0-6	13	28	39	5
AM036MX-QG-R	0-6	12	29.5	42	5
AM048MX-QG-R	0-6	11	31	43	5
AM072MX-CU-R	0-6	11	34	46	7
AM100MX-CU-R	0-6	10	35	48	7
AM150MX-CU-R	0-6	10	36.5	50	7
AM200MX-CU-R	0-6	10	38	48	7
AM300MX-CU-R	0-6	9	39.5	51	7
AM005MH2-BI-R	0-6	15	25	40	14
AM010MH2-BI-R	0-6	15	28	43	14
AM120MH2-BI-R	0-6	15	39	50	14
AM010MH4-BI-R	0-3	19	31	46	28
AM030MH4-BI-R	0-3	19	36	49	28
AM032MH4-BI-R	0-6	19	36	49	28

СВЧ транзисторы изготовленные по технологии GaN/SiC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1дВ} (дБм)	P _{sat} (дБм)	Vd (В)
AM050WN-CU-R	0-6	16.5	41.7	43	28
AM100WN-CU-R	0-6	14	44.5	46	28
AM025WN-BI-R	0-8	16	38.9	40	28
AM012WN-BI-R	0-10	17	36.1	37	28
AM005WN-BI-R	0-12	15	32	33.5	28
AM025WN-00-R	0-15	21	38.9	40.5	28
AM012WN-00-R	0-15	22	36.1	37.7	28
AM005WN-00-R	0-18	23	32	33.4	28

Типы корпусов приведены в конце брошюры.

Интегральные монолитные усилители MMIC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)
AM003536WM-BM/FM-R	0.01-3.5	23	35	36	20	20
AM012535MM-BM/FM-R	0.03-2.5	20	33	33.5	20	20
AM009023WM-BM/FM-R	0.05-9.0	21	21	23	20	12
AM008030WM-BM/FM-R	0.05-10	18	30	31	20	12
AM012020WM-BM/FM-R	0.1-2.0	30	16	17	-8	8
AM011037WM-BM/FM-R	0.2-0.3	31	37	37.5	40	8
AM103026MM-BM/FM-R	0.9-3.2	22	25	26	10	14
AM132740MM-BM/FM-R	1.3-2.7	26	38	39	30	14
AM142540MM-BM/FM-R	1.4-1.8	25	39	40	35	14
AM153040WM-BM/FM-R	1.4-3.4	18	37	38	30	12
AM143440WM-BM/FM-R	1.5-1.8	20.5	38.5	39	35	12
AM143438WM-BM/FM-R	1.5-1.8	20.5	37.5	38	30	12
AM153540WM-BM/FM-R	1.5-3.5	18	39	39.5	35	14
AM183030WM-BM/FM-R	1.6-3.3	30.5	30.5	31.5	20	8
AM183031WM-BM/FM-R	1.6-3.3	31.5	31.5	32.5	25	8
AM184635WM-BM/FM-R	1.8-4.6	30	35	37	25	7
AM204437WM-BM/FM-R	2-4.4.0	30	36	37	25	8
AM244236WM-BM/FM-R	2.4-4.2	31	36	36.5	30	8
AM254038WM-BM/FM-R	2.5-4.0	18	38	39	30	12
AM254540WM-BM/FM-R	2.5-4.5	17	38	39	35	12
AM264240WM-BM/FM-R	2.6-4.2	20	39	40	35	14
AM304031WM-BM/FM-R	2.6-4.6	31	32	32.5	25	8
AM284233MM-BM/FM-R	2.8-4.2	34	33	34	25	8
AM324036WM-BM/FM-R	3-4.2.0	29	36	36.5	25	8

Интегральные монолитные усилители MMIC изготовленные по технологии GaN/SiC

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)
AM00010037WN-SN-R	0-10	13	30	37	23	28
AM206041WN-SN-R	1.8-6.5	30	38	41	20	28

Пояснение к заголовкам таблиц: Усиление указано при малом сигнале, P_{1dB} - выходная мощность при 1дБ компрессии, P_{sat} - выходная мощность в режиме насыщения, V_d - напряжение питания

✓ Все приборы соответствуют директиве RoHS. ✓ [00] обозначает некорпусированный кристалл.

Усилители мощности модульного исполнения

(ECCN код: EAR99)

Модель	Частота (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)	Размеры (см)
AM003536SF-2H-S	0.005-3.5	22	36	37	20	24	7.11 x 5.08 x 1.42
AM003040SF-2H	0.01-3.0	22	42	43	22	24	15.24 x 10.16 x 1.68
AM000551SF-2H	0.03-0.5	28	51	51	30	28	22.35 x 8.89 x 2.31
AM003040SF-4H	0.05-3.0	43	41	42	18	24	15.24 x 8.38 x 1.68
AM003536SF-2H	0.1-3.5	22	36	37	20	22	7.11 x 5.08 x 1.42
AM020336SF-4H	0.175-0.325	60	38.5	39	34	8	8.0 x 5.46 x 1.24
AM020331SF-2D	0.225-0.3	20	31	32	25	7/-5	3.3 x 1.19 x 0.43
AM042644SF-3H	0.3-2.6	35	43	44	33	28	11.99 x 6.5 x 2.49
AM094233SF-3H	0.9-4.2	19.5	32	32.5	10	15/-5	10.16 x 7.62 x 1.91
AM131535SF-2H	1.350-1.517	31	35	36	18	16.5/-15	3.3 x 15.24 x 1.7
AM153040SF-4H	1.3-3.4	38	40	41	15	15	16.0 x 8 x 1.73
AM153042SF-4H	1.3-3.4	36	42	43	15	15	16.0 x 8.13 x 1.73
AM141940SF-2H	1.4-1.8	25	37.5	38	20	16	7.11 x 5.08 x 1.42
AM183031SF-3H	1.8-3.4	31	31	32	20	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM204437SF-3H	2.0-4.4	30	36	37	20	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM232537SF-2H двухканальный усилитель УМ / МШУ	2.1-2.6	УМ: 22 МШУ: 16 (КШ: 1.5)	37	38	20	14	7.11 x 7.62 x 1.42
AM243638SF-4H	2.4-3.6	37	38	39	15	13	6.35 x 10.16 x 2.95
AM273545SF-6H	2.5-4.0	52	44.5	45	17	12	12.07 x 20.32 x 2.54
AM304031SF-3H	2.6-4.6	29	31	32	12	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM324036SF-3H	3.2-4.2	29	35	36	23	12	7.11 x 5.08 x 1.42
AM343635SF-2H	3.4-3.6	18	36	37	27	7	3.81 x 7.11 x 1.55
AM07511242SF-3H	7.5-11.2	22.5	40.5	41.5	-	15	15.24 x 9.14 x 1.91
AM08513241SF-3H	8.5-13.2	25	40.5	41.5	-	15	15.24 x 9.14 x 1.91
AM30040031SF-3H	30.0-40.0	17	27	31	14	6	3.81 x 3.05 x 0.76

Интегральные монолитные усилители MMIC S- и C-диапазона

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)
AM072239WM-SN-R	0.7-2.2	30	38	39	25	28
AM357037WM-SN-R	3.5-7.0	26	36	37	24	8
AM357039WM-SN-R	3.5-7.0	21	37	38.5	24	14

Пояснения к заголовкам таблиц: Усиление при малом сигнале, P_{1dB} - выходная мощность при 1дБ компрессии, P_{sat} - выходная мощность в режиме насыщения, V_d - напряжение питания.

Унифицированные модульные усилители

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)
AM018033UM-3H	0.1 - 8.0	17	27	33	15	28
AM072239UM-2H	0.7 - 2.2	30	38	39	25	28
AM153540UM-2H	1.5 - 3.5	21	38	39.5	35	14
AM204437UM-3H	2.0 - 4.4	32	36	37	25	8
AM206541UM-3H	2.0 - 6.5	26	38	41	20	28
AM254038UM-2H	2.5 - 4.0	18	38	39	30	12
AM264240UM-2H	2.6 - 4.2	20	39	40	35	14
AM357037UM-3H	3.5 - 7.0	27	36	37	28	8
AM357039UM-2H	3.5 - 7.0	21	37	38.5	25	14
AM559538UM-3H	5.5 - 9.5	24	37	38	25	8
AM07511037UM-3H	7.5 - 11	25	33	37	30	5
AM07512041UM-2H	7.5 - 12.0	24	38	42	30	28
AM08011034UM-3H	8.0 - 11	25	31	34	20	5
AM08011036UM-3H	8.0 - 11	28	32	36	25	5

Для всех изделий, представленных в таблице: вес - 45 г; размеры - 38,1 x 30,5 x 14,7мм

Модульные усилители, выполненные по GaN - технологии

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Усиление (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{sat} (дБм)	КПД (%)	V _d (В)	Размеры (см)
AM006040SF-2H	0.05-6	16	40	42	24	40	10.16 x 8.13 x 2.51
AM004042SF-2H	0.05-4	24	40	42	25	50	10.16 x 8.13 x 2.51
AM206545SF-3H	2-6.5	28	38.5	45	20	40	10.16 x 7.82 x 1.42
AM02018041SF-3H	2-18	26	36.5	41	-	35	15.24 x 8.53 x 1.91
AM608038SF-3H	6-8	26	34	38.5	15	40	10.16 x 8.13 x 1.91
AM658043SF-5H	6.5-8	38	41	44	13	40	15.24 x 9.14 x 1.91
AM07512043SF-2H	7.5-12	19	40	43	15	40	10.16 x 7.82 x 1.42

Инжекторы питания в СВЧ тракт (Bias Tees)

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери по входу (дБ)	Возвратные потери по выходу (дБ)	Макс. постоянный ток (А)	Ном. ВЧ мощность (дБм)
AM000100PM-BT	0.05 - 10	0.75	15	15	2.0	30
AM000110PM-BT	0.05 - 11	0.75	17	17	2.0	33
AM000200PM-BT	300 КГц - 20 ГГц	0.75	20	20	0.8	30

Твердотельные СВЧ переключатели (SPDT T/R Switches)

(ECCN код: EAR99)

Модель	Диапазон (ГГц)	Вносимые потери (дБ)	P _{1dB} (дБм)	P _{5dB} (дБм)	V _d (В)
AM00014040TM-00	0 - 14	1.2	40	-	-15
AM00011040TM-CM-R	0 - 11	1.5	40	-	-15
AM007040TM-CM-R	0 - 7	1.0	40	43	-15

Аттенюаторы управляемые напряжением

(аттенюаторы с аналоговым управлением)

Модель	Диапазон (ГГц)	Ослабление (дБ)	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)	Управляющее напряжение (В)	IP1dB (дБм)	IIP3 (дБм)	Макс. ВЧ мощность (CW) (дБм)
AM0040PM-VVA	0-4	30	3.5	12	1-5	33	50	27*

* при работе с импульсным сигналом с коэффициентом заполнения 12.5 % максимальная входная мощность может быть повышена до 36 дБм.

Аналоговые фазовращатели

Модель	Диапазон (ГГц)	Поворот фазы	Вносимые потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)	Управляющее напряжение (В)	IP1dB (дБм)	IIP3 (дБм)	Макс. ВЧ мощность (CW) (дБм)
AM2050PM-VVP	2-5	90°	1.5 ± 0.5	12	0-5	33	40	36

Типы применяемых корпусов



Рис. 1 – Корпус CU



Рис. 2 – Корпус BI



Рис. 3 – Корпус BM



Рис. 4 – Корпус FM

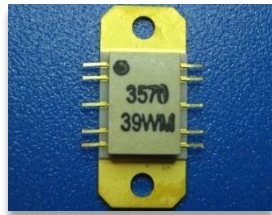


Рис. 5 – Корпус SN



Рис. 6 – Корпус CM

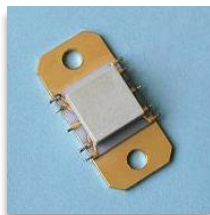


Рис. 7 – Корпус SM



Рис. 8 – Корпус QG

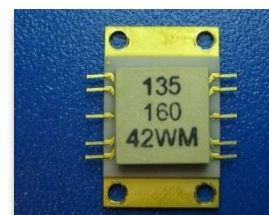


Рис. 9 – Корпус SO

На изображениях выше приведен общий вид корпусов. Полная информация, включающая габаритный чертеж корпуса содержится в технической документации на каждый компонент.

ООО «ВЕКТ»
Россия, 107207, Москва,
Щелковское шоссе д. 77
Тел.: +7(495) 228-88-98
Факс: +7(495) 228-88-98 доб. 105
www.etsc.ru • office@etsc.ru

ООО «АВАНТИ»
Россия, 197198, С-Петербург,
ул. Зверинская, д. 7-9
Тел./факс +7 (812) 327-12-70
import@avantispb.com
www.avantispb.com

